

T.		$U_f$ V	$I_f$ A	Cl.	f MHz	$U_a$ V	$U_{g2}$ V	$U_{g1}$ V	$I_a$ mA	S mA/V	$\mu$ $g_2/g_1$	$P_o$ W	$P_{g2}$ W	$P_d$ W
ГЖ 3	CCCP	10/20	3/1,5	stat	15	1750	350	- 60	6	6	10			100 <sup>1)</sup>
ГЭ 1	CCCP	11	2	stat	20	1500	250		100	2,5				80
ГЭ 2	CCCP	11	6,3	stat	20	3000	500		130	2				100
PC 1,5/100	Phi	10	2	{C-Tgr stat}	20	1500	300	-200	130	1,7	2,7	140 <sup>2)</sup>	25	85
PT 6	MOG	10	2	stat	20	1500	500	maximum	150	4	maximum		20	75

<sup>1)</sup>  $U_{g2} = 40$  V;  $I_k > 900$  mA  
<sup>2)</sup>  $I_{g2} = 55$  mA;  $I_{g1} = 2$  mA

T.	$C_{g1}$	$C_a$	$C_{g1/a}$
	pF	pF	pF
ГЖ 3	20	19	0,2
ГЭ 1	15,5	10	0,055
ГЭ 2	17	11	0,17
PC 1,5/100	28	19	0,03

**Equivalents**

Г 414	CCCP = ГЖ 3
ГКЭ-100	CCCP = ГЭ 1
ГКЭ-150	CCCP = ГЭ 2
ПЗ 1/75	Mul = PC 1,5/100
SW 75 PEN	Maz = PT 6

